



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

抗原子氧侵蚀的有机硅/二氧化硅杂化涂层及制备方法和应用

文献类型: 专利

作者 多树旺 李美栓 朱明 张亚明 周延春

发表日期 2009-04-29

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200310119054.1

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68229>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 多树旺 李美栓 朱明 张亚明 周延春. 抗原子氧侵蚀的有机硅/二氧化硅杂化涂层及制备方法和应用. 2009-04-29.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
95	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。